Silicon Standard Recovery Diode

V_{RRM} = 50 V - 300 V
I_F = 35 A

Features

- High Surge Capability
- Types from 50 to 300 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-5 Package

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANCE

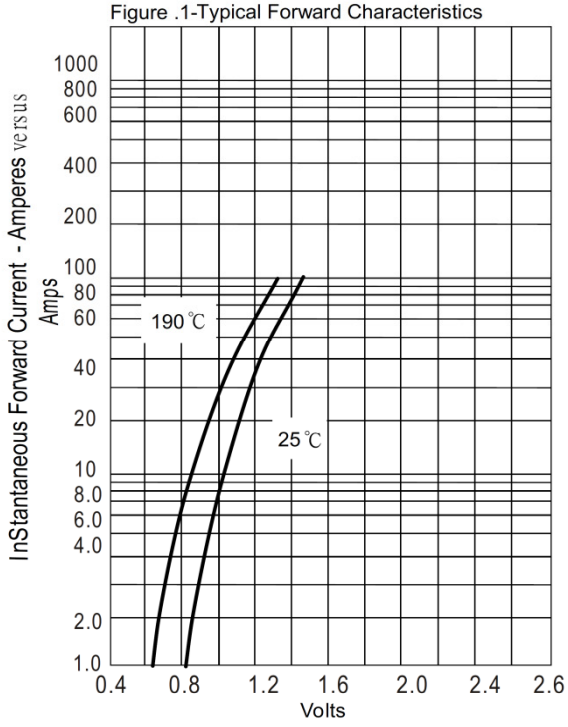
Maximum ratings, at T_j = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	1N1183 (R)	1N1184 (R)	1N1186 (R)	1N1187 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	300	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	70	140	210	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	300	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 140$ °C	35	35	35	35	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	T_C = 25 °C, t_p = 8.3 ms	595	595	595	595	A
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

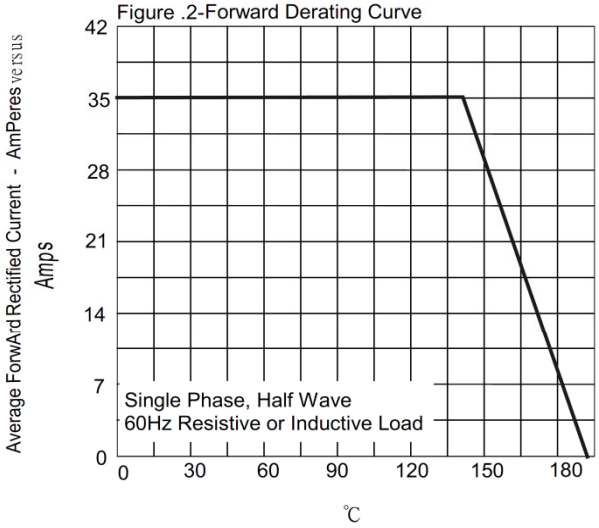
Parameter	Symbol	Conditions	1N1183 (R)	1N1184 (R)	1N1186 (R)	1N1187 (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	I_F = 35 A, T_j = 25 °C	1.2	1.2	1.2	1.2	V
Reverse current	I_R	V_R = 50 V, T_j = 25 °C	10	10	10	10	µA
		V_R = 50 V, T_j = 140 °C	10	10	10	10	mA
Thermal characteristics							
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.25	0.25	0.25	0.25	°C/W

Figure .1-Typical Forward Characteristics



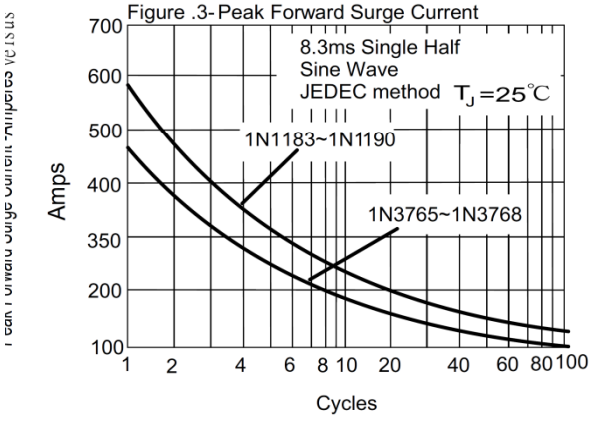
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure .2-Forward Derating Curve



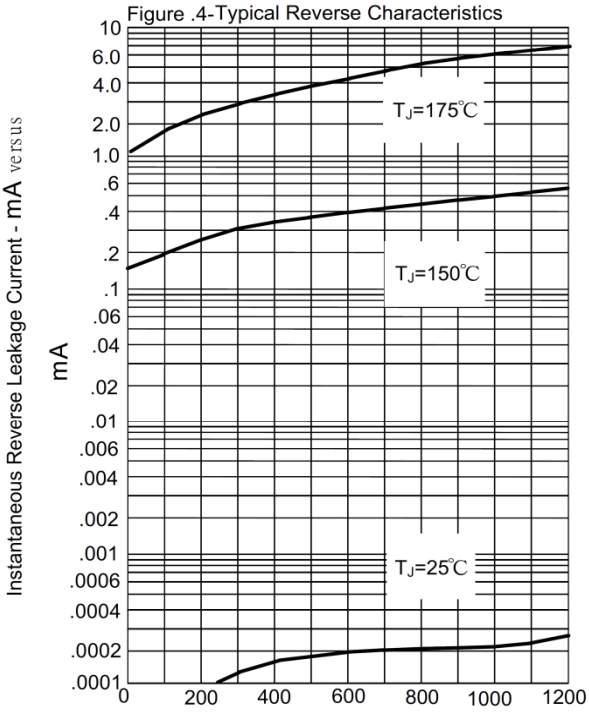
Case Temperature - ℃

Figure .3- Peak Forward Surge Current



Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

Figure .4-Typical Reverse Characteristics

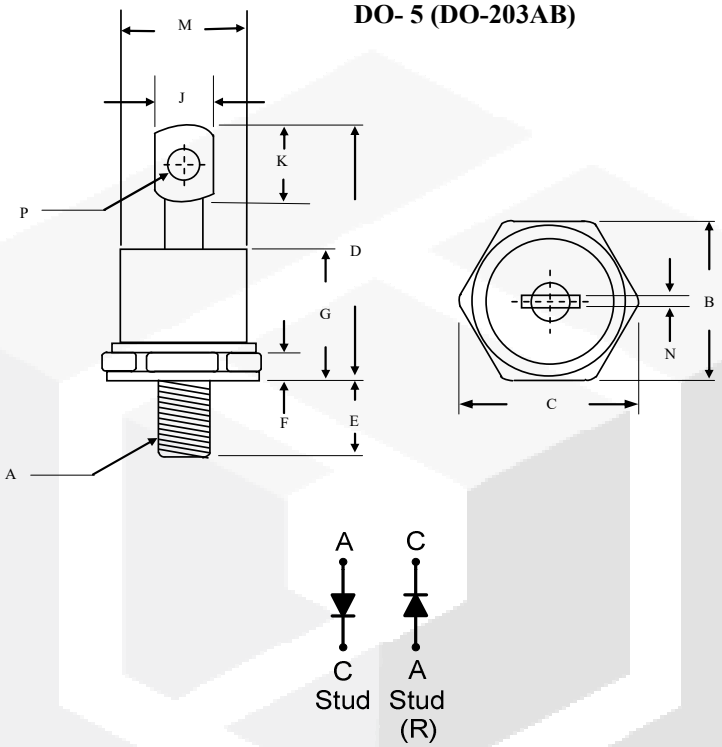


Reverse Voltage - Volts

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

DO- 5 (DO-203AB)



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	1/4 –28 UNF			
B	0.669	0.687	17.19	17.44
C	-----	0.794	-----	20.16
D	-----	1.020	-----	25.91
E	0.422	0.453	10.72	11.50
F	0.115	0.200	2.93	5.08
G	-----	0.460	-----	11.68
J	-----	0.280	-----	7.00
K	0.236	-----	6.00	-----
M	-----	0.589	-----	14.96
N	-----	0.063	-----	1.60
P	0.140	0.175	3.56	4.45

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

GeneSiC Semiconductor:

1N1183 1N1183A 1N1183AR 1N1183R 1N1184 1N1184A 1N1184AR 1N1184R 1N1186 1N1186A 1N1186AR 1N1186R 1N1187 1N1187R

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9